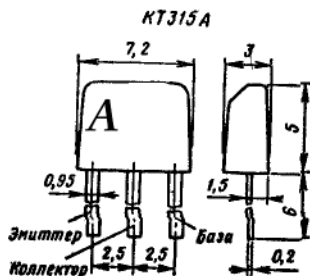


КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р



Транзисторы кремниевые, эпитаксиально-планарные структуры $n-p-n$ усилительные. Предназначены для применения в усилителях высокой, промежуточной и низкой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке, а также на корпусе прибора в виде буквы соответствующего типоминимала.

Масса транзистора не более 0,18 г.

Маркировка: буква, у КТ315 наносится сбоку корпуса, в отличие от КТ361, у которого буква посередине

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при

$U_{кв} = 10$ В, $I_k = 1$ мА:

КТ315А, КТ315В	30	120
КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е	50	350
КТ315Д	20	90
КТ315Ж	30	250
КТ315И, не менее	30	
КТ315Р	150	350

Граничная частота коэффициента передачи тока при

$U_{кв} = 10$ В, $I_k = 1$ мА, не менее

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{кв} = 10$ В

$I_b = 5$ мА, не более:

250 МГц

КТ315А	300	пс
КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	500	пс
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж	1000	пс
КТ315И	950	пс

Граничное напряжение при $I_b = 5$ мА, не менее:

КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж	15	В
КТ315В, КТ315Д, КТ315И	30	В
КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р	25	В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_k = 20$ мА, $I_b = 2$ мА, не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	0,4	В
КТ315Д, КТ315Е	0,6	В
КТ315Ж	0,5	В
КТ315И	0,9	В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_k = 20$ мА, $I_b = 2$ мА, не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	1	В
КТ315Д, КТ315Е	1,1	В
КТ315Ж	0,9	В
КТ315И	1,3	В

Обратный ток коллектора при $U_{кв} = 10$ В, не более

Обратный ток коллектор — эмиттер при $R_b = 10$ кОм,

$U_{кв} = U_{кв, макс.}$, не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р	1	мкА
КТ315Ж	10	мкА
КТ315И	100	мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{об} = 5$ В для КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р, не более
 Входное сопротивление при $U_{кв} = 10$ В, $I_k = 1$ мА, не менее
 Выходная проводимость при $U_{кв} = 10$ В, $I_k = 1$ мА, не более
 Емкость коллекторного перехода при $U_{кв} = 10$ В, не более
 КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р
 КТ315Ж, КТ315И

50 мкА
 40 Ом
 0,3 мкСм
 7 пФ
 10 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{с} = 10$ кОм

КТ315А 25 В
 КТ315Б, КТ315Ж 20 В
 КТ315В, КТ315Д 40 В
 КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р 35 В
 КТ315И 60 В

Постоянное напряжение база — эмиттер

Постоянный ток коллектора

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е 100 мА
 КТ315Р 50 мА
 КТ315Ж, КТ315И

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T \leq +25^\circ\text{C}$

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р 150 мВт
 КТ315Ж, КТ315И 100 мВт

Тепловое сопротивление переход — среда

0,67 $^\circ\text{C}/\text{мВт}$

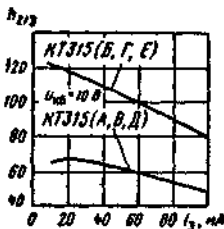
Температура р-п перехода

+120 $^\circ\text{C}$

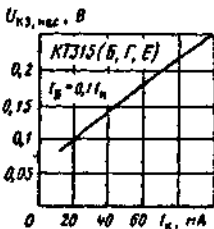
Температура окружающей среды

-60 +100 $^\circ\text{C}$

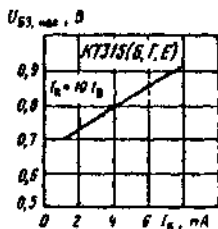
Допускается эксплуатация транзисторов в режиме $P_k = 250$ мВт при $U_{кв} = 12,5$ В, $I_k = 20$ мА



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база — эмиттер от тока базы

